

## List of Standard processes

Technology	Process	
Dry etching & DRIE	Mono-Si-trench, 20 µm Alcatel	
	Mono-Si-trench, 50 µm Alcatel	
	Mono-Si-trench, 100 µm Alcatel	
	Mono-Si-trench, 200 µm Alcatel	
	Mono-Si-trench, 380 µm Alcatel	
	Mono-Si-trench, 525 µm Alcatel	
	Mono-Si-trench, 20 µm STS	
	Mono-Si-trench, 50 µm STS	
	Mono-Si-trench, 100 µm STS	
	Mono-Si-trench, 200 µm STS	
	Mono-Si-trench, 380 µm STS	
	Mono-Si-trench, 525 µm STS	
	Nitrid, 100 nm, RIE_F	
	Nitrid, 200 nm, RIE_F	
	Nitrid, 500 nm, RIE_F	
	Nitrid, 1000 nm, RIE_F	
	Nitrid, 2000 nm, RIE_F	
	Oxid, 100 nm, RIE_F	
	Oxid, 200 nm, RIE_F	
	Oxid, 500 nm, RIE_F	
	Oxid, 1000 nm, RIE_F	
	Oxid, 2000 nm, RIE_F	
	Si, Markenbasis, RIE_F	
	Si, 100 nm, RIE_F	
	Si, 500 nm, RIE_F	
	Si, 1000 nm, RIE_F	
	Si, 2000 nm, RIE_F	
	Si, 3000 nm, RIE_F	
	Si, 5000 nm, RIE_F	
	WTi10, RIE_F	
	Nitrid, 1000 nm, Alcatel	
	Nitrid, 2000 nm, Alcatel	
	Nitrid, 500nm, STS	
	Nitrid, 1000nm, STS	
	Nitrid, 2000nm, STS	

	Oxid, 1000nm, Alcatel
	Oxid/Nitrid/Oxid-Stack, Alcatel
	Oxid, 2000nm, Alcatel
	Oxid, 1000 nm, STS
	Oxid, 2000 nm, STS
	Oxid, 2000 nm, STS
Lithography	PR 1,8 µm, Gesamtprozess
	PR 3,9 µm, Gesamtprozess
	PR 6,5 µm, Gesamtprozess
	PR 10,0 µm, Gesamtprozess SoT
	PR 30 µm, Gesamtprozess SoT
	Negativ-Resist, Gesamtprozess
	Polyimid, Gesamtprozess
	SU-8 Lack , Sonderprozess
	Lackveraschung, Barrel
	Trockenfilmresist/ Laminator
	Polyimid
Electroplating	Gold, 1-5 µm
	Gold, 5-15 µm
	Gold, 15-25 µm
	Kupfer, 1-5µm
	Kupfer, 5-15µm
	Kupfer, 15-25µm
	Nickel, 1-5 µm
	Nickel, 5-15 µm
	Nickel, 15-25µm
Test & Inspection	Messung Linienbreite
	Messung Partikelanzahl
	Messung Schichtdicke Zeiss Interferometer
	Messung Schichtdicke Ellipsometer
	Messung Schichtwiderstand
	Messung Stufenhöhe AlphaStep
	Messung Stufenhöhe UBM
	Messung Stufenhöhe z-Messplatz
	Messung Waferdicke / TTV
	Messung Waferdurchbiegung / Schichtstress

Wet etching & Cleaning	Alketch
	Au Etch plus
	basische Chrom Ätze
	Cr Etch plus
	Eisen(III)-chlorid
	Flusssäure 50%
	Flusssäure 50% / Salzsäure 37% Gemisch
	HF-Gasätzen
	Iod-Lösung 0,1mol
	Kalilauge, KOH, w = 30%
	Königswasser
	Lackentfernung, Aceton, Convac
	Lackentfernung, DMSO
	Lackentfernung, Remover DFA
	Lackentfernung, Solvent NMP-AE 5050
	Oxide Etch 7: 1, modified
	Phosphorsäure 85%
	Phosphorsäure-Ätzmischung PWS 80-16-4 (65)
	Porosifizieren
	Reinigung, Carosche Säure
	Reinigung, Carosche Säure
	Reinigung, HF 1%/SC2
	Reinigung, HF 1%-Dip
	Reinigung, SC1/HF 1%
	Salpetersäure-Ätzmischung SWF 63-33-4
	saure Ätze, Chrom Etch 3144
	Tetramethylammoniumhydroxid, TMAH
	WTi Etch plus
	Yield-Up
	Yield-Up
Furnace & LPCVD	Si (p-dotiert/undotiert), 100 nm
	Si (p-dotiert/undotiert), 250 nm
	Si (p-dotiert/undotiert), 500 nm
	Si (p-dotiert/undotiert), 750 nm
	Si (p-dotiert/undotiert), 1000 nm
	Si (p-dotiert/undotiert), 1500 nm
	Si (p-dotiert/undotiert), 3000 nm
	TEOS, 100 nm
	TEOS, 250 nm

	TEOS, 500 nm
	TEOS, 750 nm
	TEOS, 1000 nm
	TEOS, 1500 nm
	Thermisches Oxid (trocken), 50 nm
	Thermisches Oxid (trocken), 100 nm
	Thermisches Oxid (feucht), 100 nm
	Thermisches Oxid (feucht), 500 nm
	Thermisches Oxid (feucht), 1000 nm
	Thermisches Oxid (feucht), 1500 nm
	Thermisches Oxid (feucht), 2000 nm
	Nitrid, stöchiometrisch, 100 nm
	Nitrid, low stress, 100 nm
	Nitrid, low stress, 200 nm
	Nitrid, low stress, 300 nm
	Nitrid, low stress, 500 nm
	POCl <sub>3</sub> -Dotierung
	Temperung (Formiergas)
	Temperung (180min n-Diffusion)
	Temperung (180min p-Diffusion)
PECVD deposition	SiN-hf, Zugspannung, 500 nm
	SiN-hf, Zugspannung, 1000 nm
	SiN-lf, Druckspannung, 500 nm
	SiN-lf, Druckspannung, 1000 nm
	SiN-mf, low-stress, 500 nm
	SiN-mf, low-stress, 1000 nm
	SiN-mf, low-stress, 2000 nm
	SiO <sub>2</sub> -hf, low-stress, 500 nm
	SiO <sub>2</sub> -hf, low-stress, 1000 nm
	SiO <sub>2</sub> -hf, low-stress, 2000 nm
	SiO <sub>2</sub> -lf, Druckspannung, 500 nm
	SiO <sub>2</sub> -lf, Druckspannung, 1000 nm
	SiO <sub>2</sub> -lf, Druckspannung, 1000 nm
	SiON-hf, low-stress, 500 nm
	SiON-hf, low-stress, 1000 nm
Metallization / PVD	Al 5n, 500nm, Balzers
	Al 5n, 1000nm, Balzers
	Al 5n, 2000nm, Balzers

	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 200nm, Balzers
	Chrom, 15nm + Gold, 80nm (Platingbase), Balzers
	Chrom, 15nm + Kupfer, 80nm (Platingbase), Balzers
	Chrom, 50nm, Balzers
	Chrom, 100nm, Balzers
	Gold, 100nm, Balzers
	Gold, 500nm, Balzers
	Gold, 1000nm, Balzers
	Gold, 2000nm, Balzers
	Kupfer, 100nm, Balzers
	Kupfer, 500nm, Balzers
	Kupfer, 1000nm, Balzers
	Platin, 100nm, Balzers
	Platin, 250nm, Balzers
	Platin, 500nm, Balzers
	Platin, 1000nm, Balzers
	Tantal, Sonderdicke, Balzers
	TiN, reaktiv, Sonderdicke, Balzers
	Titan, 50nm, Balzers
	Titan, 100nm, Balzers
	Al 5n, 1000nm, MRC
	Al 5n, 2000nm, MRC
	WTi10, 100 nm, MRC
	WTi10, 200 nm, MRC
Wafer Bonding	Anodisches Wafer-Bonden
	Ausheilung nach Wafer-Bonden (SDB/SFB)
	Si-Direktbonden (SDB/SFB)